PFNインダクタンスの自動調整システム

横山 和枝^{1,A)}、佐藤 勇^{A)}、早川 建^{A)}、田中 俊成^{A)}、早川 恭史^{A)}、
境 武志^{B)}、菅野 浩一^{B)}、石渡 謙一郎^{B)}、中尾 圭佐^{B)}、長谷川 崇^{B)}
A) 日本大学量子科学研究所、^{B)} 日本大学大学院理工学研究科
〒274-8501 千葉県船橋市習志野台7-24-1 電子線利用研究施設

概要

日本大学電子線利用研究施設(LEBRA)^[1]では、 クライストロンモジュレータのパルス形成回路 (Pulse-Forming-Network:以下PFNと略す)のイン ダクタンス調整をすべて遠隔操作できるようにして ある^[2]。そのため、パルス波形の平坦度が容易に調 整できるという利点がある。これまでは30段のPFN のインダクタンス調整を手動で行っていたが、今回、 パソコンを通して操作できるように改良した。また、 最適な平坦度を出すために適切なインダクタンスの 組み合わせを計算し、これを基にPFN調整を行った。

1.はじめに

FEL高利得のためには、光共振器のミラー間を往 復する光パルスと入射電子ビームのミクロパルスの タイミングを一致させることが必要不可欠である。 クライストロンの印加電圧の変動は、マイクロ波出 力の振幅と位相の変動となる。この位相変動は共振 器内での光パルスと電子パルスの空間的重なりを不 安定にする要因の一つである。そのため、FEL用電 子ビームには平坦度の良いパルスが得られるPFNが 要求される。LEBRAのRFリニアック(加速周波数 2856MHz、パルス幅20µs)の電子ビームバンチ長は 5ps程度である^[3]。光パルスと電子パルスを10%以内 の精度で重ねることを要求すると、パルス内の位相 変動を0.5°以内に抑える必要がある。印加電圧変動 とクライストロン出力RFの位相変動の関係^[4]から、 これに要するパルス平坦度は0.08%である。また、 このときの加速電圧変動は、クライストロン出力RF の電力変動の関係式^[5]から0.1%である。

2.パルス形成回路

図1にパルスモジュレータの等価回路を示す。 PFNは30段のインダクターとコンデンサーから成る。 インダクタンスは、図2の写真のようにコイルを巻 きつけた筒にモーター駆動によってアルミシリン ダーを出し入れすることにより変えることができる。 シリンダーの挿入長はポテンショメータを利用して、 パネルメータに電圧表示される。モーターはデジタ ル1/0ボードを通してパソコンで制御される。



図2:PFNの一部。右側がインダクター部で、筒の中に アルミシリンダーがあり、これをコイルの巻いてある ボビンに出し入れすることにより、インダクタンスを 変える。アルミシリンダーの駆動範囲は約9cmである。



¹ E-mail: k_yokoyama@lebra.nihon-u.ac.jp

図1:パルスモジュレータ等価回路。

インダクターは、コイルの巻き方等に個性があ り、インダクタンスの値も異なるので、それぞれ のインダクタンスを測定した。測定結果を図3に 示す。アルミシリンダーが筒に挿入されていない ときが、インダクタンスの最大値に対応する。ま た、接触抵抗、ケーブルの直列インピーダンス、 ケーブルや端子間の浮遊容量による誤差が大きい ため、試験的に3つのインダクターを選んで数回 測定を行った。その結果、±5%程度のばらつきが あった。また、インダクタンスの可変量の設計値 は、1.73µH~3.56µHであるので、高めに測定され ていると思われる。



図3:インダクタンスの変化。(インダクタンスの最大 値が筒にアルミシリンダーを挿入していないとき。)測 定器(LCRメータ)は、ZM 2355^[6]。

3.計算

3.1 方法

平坦度の良いパルス電圧波形を求めるために、 次のような計算を行った。目標とするパルス電圧 波形の関数を $g(t_i)$ とし、基準になる電圧を V_i その ときのパルス波形を $f(t_i)$ 、インダクタンスを L_j 、 変化分を ΔL_j 、(i=0,n、任意の時刻、j=0,29、イ ンダクタンスの番号)とすると、一次の近似では 次式のように表わされる。

$$g(t_i) = f(t_i) + \frac{\partial f(t_i)}{\partial L_0} \Delta L_0 + \dots + \frac{\partial f(t_i)}{\partial L_j} \Delta L_j$$

この関数が、電圧Vの平坦部を持つように二乗偏差 $\Sigma(V-g(t_i))^2$ を最小にする ΔL_i を求める。すなわち、

$$\frac{\partial}{\partial L_{j}} \sum_{i=0}^{n} \left\{ V - g(t_{i}) \right\}^{2} = 0$$

を求める。これを展開すると、
$$V \sum_{i=0}^{n} \frac{\partial f(t_{i})}{\partial L_{j}} = \sum_{i=0}^{n} f(t_{i}) \frac{\partial f(t_{i})}{\partial L_{j}} + \sum_{i=0}^{n} \sum_{k=0}^{29} \frac{\partial f(t_{i})}{\partial L_{j}} \frac{\partial f(t_{i})}{\partial L_{k}} \Delta L_{j}$$

となる。ここで、それぞれのマトリックスを次の ように置き換えると、

 $VA = B + C \cdot D$ $D = C^{-1} \cdot (VA - B)$

となり、Dが求まれば、それぞれのインダクタンス Lの最適値が求まる。ただし、ALが小さい場合に成 り立つ近似であり、基準にする電圧Vには制限があ るため厳密には成り立たない。また、図2の測定 結果よりL_iも制限される。

3.2 シミュレータ

3.1で説明した計算方法が有効であるかどうかを 調べるために、SPICEを用いた回路シミュレータ (CircuitMaker2000)^[7]を利用して、パルス電圧 波形の計算を行った。シミュレーションには、図 1で示したように、PFNとスイッチング部(サイラ トロン等)と負荷(クライストロン等)から構成 される等価回路を使用した。HVは充電電圧、Rはパ ルストランスの1次側からみたクライストロンのイ ンピーダンス、A点はパルス電圧の計算点である。 コンデンサーの容量は、クライストロンモジュ レータ作成時に測定したデータを利用した。Rは、 $Z_{k}=1/K \cdot V_{k}^{-1/2}$ (Kuthar the Kuthar the Kuth Vkは印加電圧)から求まる^[5]が、PFNのインピーダ ンスとのマッチングを取る必要がある。実際に設 定されているLの絶対値が精密にはわからないため、 回路シミュレータで用いるRは、パルス電圧を測定 し、その波形に近くなるような値にした。また、L 値は、図2の測定から設定されている値に近いと 思われるL_i=3.0µHに統一して計算した。図4にHVを 20.5kVにしたときに測定したパルス電圧と回路シ ミュレータで得られた波形を示す。

3.3 計算例

図4からわかるように、回路シミュレータで得られた波形は、測定したパルス電圧波形に近い。 さらに、平坦度の高いパルスを得るために、回路 シミュレータと図1の等価回路を用いて、3.1の計 算を行った。計算では、 $\frac{\partial f}{\partial L_j} \cong \frac{f(L_j + \delta L_j) - f(L_j)}{\delta L_j}$

で近似した。ここで、 f(t_i)は、L_j=3.0µHと値を全 て同じにした関数で、インダクタンス変化量は $\delta L_i=0.01\mu$ Hにした。また、Vの値は18.5kV~22.5kV で0.05kVステップで計算し、2.0<Li<3.5[µH]で制限 した。さらに、目標とするパルス電圧波形 $g(t_i)$ を 決めるパルス幅tiも制限されるので∆Liを絞り込む ことができる。t_iの計算ステップは0.1µsにした。 図4の測定したパルス電圧波形と計算で得たLi値を 使ったシミュレータ波形を図5に示す。計算の結 果、Vの値が20.6kVで良い解が得られた。計算結果 (1) は 2.0<ti<22.0[µs] 、計算結果 (2) は 2.2<t_i<24.2[µs]で計算した解を用いたパルス波形 である。計算結果(1)は、パルスの平坦度はパルス 幅16.5µsで0.06%である。計算結果(2)は、パルス 幅18.5µsで平坦度0.1%である。この計算結果から 測定データよりも平坦度を良くすることは可能で あると思われる。

4.PFN調整

実際のPFN調整では、各インダクタンスを δL_i=0.02μH(パネル電圧表示で0.018V)づつ変化さ せて各々のパルス電圧波形を測定し、3.1の方法で 計算を行った。パルス電圧波形の測定データには、 ノイズが0.04%程度(0.01V/24.5V)含まれている ので、この影響を小さくするために20パルスのア ベレージ波形をさらに移動平均を取って処理した。 L値の絶対値はわからないが、図3の曲線から局所 的にはパネル電圧とL値が比例すると思われるので、 △Liから相対値はわかる。図6にこの方法でPFN調 整を行う前と行った後のパルス電圧波形を示す。 調整後(1)は2.1<*t*i<23.1[µs]、調整後(2)は 1.9< t_i<23.6[µs]で計算した解を用いた。調整前は、 湾曲になっていた波形(平坦部は0.16%)が、計算 で得られたALiの分を変えたことによって平坦度が 改善された。調整後(2)では、17.5µsのパルス幅で、 0.12%の平坦度が得られている。

5.まとめ

パルス電圧波形の平坦度は改善されたが、ノイ ズの影響があるので、この調整方法ではパルス平 坦度0.1%までが限界と思われる。今後は、パルス 電圧波形平坦度の評価として、クライストロン出 力RF位相を利用する方法を試みる予定である。ま た、調整精度をあげるためにはパネル電圧とL値の 対応関係を較正する必要がある。さらに、計算で 得られるインダクタンスの組み合わせが複数ある ので、PFNインダクタンスの自動調整システムを確 立するためにはインダクタンスの最適値を求める アルゴリズムの改良が必要である。



図4:パルス電圧波形。測定データ(HV=20.5kV)と回 路シミュレータでの計算例(L=3.0µs)。



図5:パルス電圧の測定データと計算結果を使って得られた平坦度の高いシミュレータ波形。



図6: PFN調整結果(パルス平坦部)。

参考文献

- [1] 佐藤 勇、他., "日本大学電子線利用研究施設の現状", Proc. of this Meeting.
- [2] 早川 建、他., "日大FELの建設", Proceedings of the 21th Linear Accelerator Meeting in Japan, p.20, 1996.
- [3] Hiroyuki Nakazawa. et al., "Radiation form the FEL Undulator at Nihon University", Proceedings of the 12th Symposium on Accelerator Science and Technology, p.394, 1999.
- [4] R.B.Neal, General Editor, "THE STANFORD TWO-MILE ACCELERATOR", W.A.Benjamin, Inc., p.294, 1968.
- [5] 設楽哲夫, "高周波源", OHO'90, p. -5, 1990.
- [6] URL: http://www.nfcorp.co.jp/
- [7] URL: http://www.circuitmaker.com/